СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Коронксвич В. П., Полещук А. Г., Пальчикова И. Г. Считывание информации с компакт-дисков лазерной головкой с дифракционной оптикой // Квантовая электрон.-1988.— № 40.

- 1988.— № 10.
 Донцова В. В., Ленкова Г. А., Михальцова И. А. Исследование параметров дифракционных микрообъективов // Автометрия.— 1989.— № 2.
 Борн М., Вольф Э. Основы оптики.— М.: Наука, 1973.
 Донцова В. В., Ленкова Г. А., Чурин Е. Г. Влияние спектра полупроводникового лазера на ФРТ дифракционного микрообъектива для лазерной считывающей головки // Компьютерная оптика.— М.: МЦНТИ, 1989.— № 5.

Поступила в редакцию 31 июля 1989 г.

9

удк 621.378.325 : 535.317

В. А. ДОМБРОВСКИЙ, С. А. ДОМБРОВСКИЙ, Е. Ф. ПЕН, А. Н. ПОТАЦОВ, З. Л. ПУСТОВАЯ (Повосибирск)

СТЫКОВКА ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА видимого диапазона с одномодовым волокопным световодом

Введение. Полупроводниковые лазеры видимого диапазона и одномодовые волоконные световоды (OBC) открывают новые возможности в голографической технике, и в частности в области голографической памяти. Эти элементы обеспечивают компактность, гибкость, многоканальность оптической системы, позволяют легко формировать пучки высокого качества и управлять их параметрами.

Для эффективного соединения полупроводникового лазера с ОВС необходимо преобразовать эллиптический лазерный пучок в круглую волноводную моду. Известен целый ряд методов сопряжения полупровод-никового лазера с ОВС [1-18]. В [1, 2, 4, 7, 10, 17, 18] исследован метод соединения полупроводникового лазера с ОВС нутем прямой стыковки. Достигнута эффективность ввода излучения полупроводникового лазера в ОВС $K = \hat{10} - 25$ %. В [3, 4] фотолитографическая техника использовалась для создания сферических и цилиндрических микролинз с днаметром 4 — 10 мкм на торце ОВС. Эффективность ввода излучения составляла $K \simeq 40$ %. В [7, 9] стыковка полупроводникового лазера с ОВС осуществлялась с помощью линзы «Selfoc» ($K \simeq 22$ %), а в [10] — фокона, который создавался на торце ОВС (K = 10 - 23 %). В [5-8, 10] в качестве цилиндрической липзы применялся отрезок волоконного световода диаметром 6 — 20 мкм, помещаемый между ОВС и полупроводниковым лазером. Эффективность ввода доходила до 70 %. Расчет эффективности стыковки полупроводникового лазера с ОВС и формулировка требований к точности установки основных элементов для различных способов проведены в [7]. Деластся вывод, что метод цилиндричсской линзы наиболее подходящий, хотя требования к точности установки элементов здесь являются высокими. В [11, 12] предложен эффективный метод соединения полупроводникового лазера, имеющего небольшую асимметрию диаграммы излучения, с ОВС, основанный на использовании двух сферических линз, установленных софокусно. Этот метод обеспечивает достаточно высокую эффективность (~40 %) при допустимой точности установки элементов.

🙃 1990 Домбровский В. А., Домбровский С. А., Пен Е. Ф.,

Потапов А. Н., Пустовая З. Л.



В данной статье теоретически и экспериментально исследуется эффективность способа стыковки полупроводникового лазера со значительной асимметрией диаграммы излучения с одномодовым волокопным световодом, сочетающего методы цилиндрической линзы и софокусных сферических линз. Предполагается, что в этом случае может быть достигнута высокая эффективность ввода излучения в ОВС при относительно низких требованиях к точности установки оптических элементов.

Метод цилиндрической микролинзы. Предположим, что пучок в плоскости выходного зеркала полупроводникового лазера описывается гауссовой функцией [1, 2], причем ω_{\parallel} и ω_{\perp} являются радпусами пучка на уровне e^{-2} по интенсивности соответственно в плоскости, параллельной и перпендикулярной p - n-переходу. Для полупроводникового лазера $\omega_{\parallel} > \omega_{\perp}$, при этом расходимость

$$\Theta_{\perp} = \lambda / \pi \omega_{\perp} > \lambda / \pi \omega_{\parallel} = \Theta_{\parallel}.$$

На некотором расстоянии $z_{0,n_{T}}$ от лазера размеры пучков становятся равпыми (рис. 1, *a*): $\omega_{\parallel} = \omega_{\perp}$. Расстояние $z_{0,n_{T}}$ находится из формулы $z_{0,n_{T}} = q_{\parallel}\omega_{\perp}/\omega_{\parallel} = \pi\omega_{\perp}\omega_{\parallel}/\lambda$, которая получается на основе выражения [19]

$$\omega'_{\perp,\parallel} = \frac{\lambda}{\pi \omega_{\perp,\parallel}} \left[q_{\perp,\parallel}^2 + z^2 \right]^{1/2}, \qquad (1)$$

описывающего изменения размера гауссового пучка по мере удаления от лазера. Здесь $\lambda - длина$ волны излучения лазера, $q_{\perp,\parallel} = \pi \omega_{\perp,\parallel}^2 / \lambda -$ обобщенный параметр лазерного пучка в плоскости, периендикулярной (-L) п нараллельной (-L) p - n-переходу.

Для достижения максимальной эффективности ввода K, как следует из выражения [20, 8]

$$K = K_{\perp} K_{\parallel}, \qquad (2)$$

$$K_{\perp,\parallel} = \frac{2}{\left[\left(\frac{\omega_0}{\omega'_{\perp,\parallel}} + \frac{\omega'_{\perp,\parallel}}{\omega_0}\right)^2 + \left(\frac{\pi \omega'_{\perp,\parallel} \omega_0}{\lambda R_{\perp,\parallel}}\right)^2\right]^{1/2}},$$

еще педостаточно согласовать размеры лазерного пучка ω_{\pm} , ω_{\parallel} с радпусом основной моды ω_0 OBC ($\omega_{\perp}' = \omega_{\parallel}' = \omega_0$). Необходимо выполнить также определенные требования на величину радпусов кривизны фронта лазерного пучка R_{\perp} и R_{\parallel} в плоскости входного торца OBC:

$$R_{\perp,0} \ge q_0,$$

10

где $q_0 = \pi \omega_0^2 / \lambda_{-}$ обобщенный параметр основной моды OBC. Например, при $R_{\perp \parallel} = q_0$ эффективность ввода надает на 20 %.

Радиусы кривизны фронта лазерного нучка с увеличением расстояния з изменяются по закону [19] $R_{\perp,\parallel} = z + q_{\perp,\parallel}^2 / z$. Если входной торец ОВС располагается на расстояния $z_{\text{онт}} = q_{\parallel}\omega_{\perp}/\omega_{\parallel}$ от лазера, то $R_{\parallel} =$ $= q_{\parallel}\eta \left(1 + \frac{1}{\eta^2}\right), R_{\perp} = q_{\parallel} \frac{1}{\eta} \left(1 + \frac{1}{\eta^2}\right),$ или в предположении, что $\omega'_{\perp} =$ $= \omega'_{\parallel} = \omega_0, a \eta^2 = \omega_{\parallel}^2 / \omega_{\perp}^2 \gg 1, R_{\parallel} \simeq q_0\eta; R_{\perp} \simeq q_0/\eta.$ В этом случае выражение (2) для коэффициента эффективности ввода K преоблазуется в виде

ввода К преобразуется в виде

$$K = \frac{4}{(4+1/\eta^2)^{1/2} (4+\eta^2)^{1/2}}$$

Например, при $\eta = 3 K = 55 \%$, а при $\eta = 8 K = 20 \%$.

Таким образом, понятно, что при значительной ($\eta = \omega_{\parallel} / \omega_{\perp} > 3$) асимметрии площадки излучения полупроводникового лазера необходимо корректировать радиус фронта волны в плоскости, периендикулярной *p* — *n*-переходу. Это можно сделать с помощью цилиндрической линзы, фокусное расстояние которой выбирается из выражения

$$f_{\text{ont}} = z_{\text{ont}} = (\pi \omega_{\perp} \omega_{\parallel}) / \lambda = q_{\parallel} / \eta.$$
(3)

(Напрамер, при $\lambda = 0.66$ мкм; $\omega_{\parallel} = 2.5$ мкм; $\omega_{\perp} / \omega_{\perp} = 9$ $q_{\parallel} \simeq 30$ мкм, а funt = 3,3 мкм.) Заметим, что входной торец ОВС целесообразно располагать в главной плоскости цилиндрической линзы. При этом $R_i =$ $= -R_{\perp} \simeq q_{\parallel} \omega_{\perp} / \omega_{\perp}, \omega'_{\parallel} = \omega'_{\perp}$ и, например, если $\omega'_{\parallel} = \omega_0$, то расчетная эффективность ввода излучения полупроводникового лазера в ОВС близќа к 100 %.

В качестве цилиндрической микролинзы можно использовать отрезок оптического волокна (рис. 1, б). Диаметр волокна D связан с фокусным расстоянием формулой толстой линзы

$$f=nD/4(n-1),$$

где n — показатель преломления световолокна. Например, при n = 1,5;f = 3 MKM, D = 4 MKM.

Хотя эффективность ввода излучения полупроводникового лазера в ОВС с использованием таких цилиндрических линз оказывается высокой (экспериментально до 70 %), однако допуски на погрешность установки элементов здесь очень жесткие (доли микрона) [7]. Кроме того, на практике возникают трудности, связанные с малыми расстояниями между лазером, цизиндрической микролинзой и ОВС.

Метод софокусных сферических липз. Требования к точности установки оптических элементов могут быть значительно ослаблены, если использовать цилиндрические линзы с фокусным расстоянием, значительно (примерно на порядок) большим, чем оптимальное four. Однако в этом случае падает эффективность ввода. Исследуем зависимость эффективности ввода К от фокусного расстояния цилиндрической линзы.

Раднусы лазерного пучка ω_{\parallel} , ω_{\perp}' в главной плоскости цилиндриче-ской линзы с фокусным расстоянием f определяются выражением (1):

$$\omega'_{\parallel} = \omega_{\parallel} \sqrt{1 + f^2/q_{\perp}^2}; \qquad (4)$$

$$\dot{\omega}_{\perp} = \frac{\omega_{\parallel}}{\eta} \sqrt{1 + \eta^4 f^2/q_{\parallel}^2} \,, \tag{5}$$

где $\eta = \omega_0 / \omega_\perp$. Введем параметр

$$l = \omega'_{\perp} / \omega'_{\parallel} = \sqrt{1 + \eta^4 f^2 / q_{\parallel}^2} / \eta \sqrt{1 + f^2 / q_{\parallel}^2}, \qquad (6)$$

который понадобится в дальнейших расчетах.

11

Радиус основной моды ОВС ω_0 в общем случае не совпадает с размером лазерного пучка ни в параллельной ω_{\parallel} , ни в перпендикулярной ω_{\perp}' плоскостях p - n-перехода. Для согласования лазерного пучка с основной модой ОВС целесообразно использовать две сферические линзы, установленные софокусно (рис. 1, в). Причем фокусные расстояния этих линз f1 и f2 выбираются из условия, максимизирующего эффективность ввода К [11]:

$$m_{\text{OHT}} = f_2 / f_1 = \omega_0 / \sqrt{\omega_\perp \omega_\parallel}, \qquad (7)$$

которое с учетом (4) и (5) преобразуется следующим образом:

$$m_{\rm off} = V \sqrt{\frac{q_{\rm o}}{lq_{\parallel}}} \frac{1}{\sqrt{1 + f^2/q_{\parallel}^2}}.$$
 (8)

Выражения для радиусов кривизны фронта лазерного пучка в плоскости, параллельной R''_{\parallel} и перпендикулярной R_{\perp} " p-n-переходу, на входном торце ОВС имеют вид

$$R''_{\parallel,\perp} = m^2_{\text{ont}} R'_{\parallel,\perp},$$

где

$$\begin{aligned} R'_{1} &= f \left(1 + q_{1}^{2} / f^{2} \right), \\ R'_{1} &= -f \left(1 + n^{4} / r^{2} / q_{1}^{2} \right) \end{aligned}$$

или

$$R''_{\parallel} = q_0 / (l(f/q_{\parallel})), \tag{9}$$

$$R_{\perp}'' = -q_0 l \eta^2 (f/q_{\parallel}). \tag{10}$$

Подставляя (9) и (10) в (2) и учитывая соотношения $\omega_{\perp}{}'' = \omega_0 \gamma \bar{l}$, $\omega_{\parallel}^{''}=\omega_0/V\,l,\,\,$ для эффективности ввода излучения полупроводникового лазера в ОВС получим

$$K_{\max} = \frac{4}{\left[\left(\sqrt{l} + \frac{1}{\sqrt{l}}\right)^2 + l\left(\frac{f}{q_{\parallel}}\right)^2\right]^{1/2} \left[\left(\sqrt{l} + \frac{1}{\sqrt{l}}\right)^2 \div \frac{1}{l^2 \eta^4 (f/q_{\parallel})^2}\right]^{1/2}}.$$
 (11)

Графики зависимостей K_{\max} , $1/m_{\text{опт}} = f_1/f_2$. $l = \omega_{\perp}'/\omega_{\parallel}'$ от относительного фокусного расстояния цилиндрической линзы f/q_{\parallel} , рассчитанные из выражений (11), (8) и (6) при $\eta = 8$ и $q_0/q_{\parallel} = 1$, показаны на рис. 2. Из графиков видно, что максимальная эффективность ввода ($K_{\max} \simeq 100$ %) получается, когда $f_{\text{опт}} = q_{\parallel}/\eta = 0,125$. С увеличением фо-



Рис. 2. Зависимости K, f_1/f_2 , $\omega'_{\perp}/\omega'_{\parallel}$ от фокусного расстояния цилиндрической микролинзы f/q_{\parallel}



12



Рис. 4. Распределение интенсивности излучения полупроводникового дазера ИЛПМ-2-71К-А в дальней зоне в илоскости, параллельной I_{1} и перпендикулярной I_{\perp} p = -n-переходу:

а — для трех значений тока накачки; б — для трех образцов полупроводникового лазера

кусного расстояния в 4 и 8 раз по сравнению с оптимальным эффективность падает, но остается еще достаточно высокой: 64 и 39 % соответственно. При этом требования к точности установки цилиндрической липзы снижаются пропорционально увеличению ее фокусного расстояния, т. е. в 4 — 8 раз.

Эксперимент. В эксперименте использовался импульсный полупроводниковый лазер ИЛПИ-2-7К-А ($\lambda = 665$ нм, $\Delta \lambda = 0,1$ нм, $\tau_{им\pi} = 1$ мкс, $P_{им\pi} = 10$ мВт, скважность 10). Для стыковки полупроводниковых лазеров с одномодовыми световодами по схеме рис. 1, в применялись цилиндрические линзы, в одном случае с фокусным расстоянием первой линзы $f^{(1)} = 45$ мкм (диаметр отрезка оптического волокна $D^{(1)} = 60$ мкм), в другом — с $f^{(2)} = 22,5$ мкм ($D^{(2)} = 30$ мкм).

Радпусы ω_0 , ω_{\perp} , ω_{\parallel} рассчитывались по результатам измерений распределений интепсивности излучения на выходс ОВС (рис. 3) и полупроводникового лазера (рис. 4) в дальней зоне на основе выражения (1). Полученные значения для радиусов пучка полупроводникового лазера $\omega_{\perp} \simeq 0.35$ мкм, $\omega_{\parallel} \simeq 3$ мкм и ОВС $\omega_0 \simeq 2.4$ мкм использовались далее для расчста параметров оптической схемы и оценки эффективности вгода. Обобщенный параметр пучка полупроводникового лазера $q_{\parallel} = \pi \omega_{\parallel}^2 / \lambda = 42.5$ мкм, обобщенный параметр основной моды OBC $q_0 =$ $= \pi \omega_0^2 / \lambda = 27.2$ мкм, $\eta = 8.6$; $l^{(1)} = (\omega'_{\perp} / \omega'_{\parallel})^{(1)} = 6.25$; $l^{(2)} = (\omega'_{\perp} / \omega'_{\parallel})^{(2)} = 4$; $(f_1/f_2)^{(1)} = 4.6$; $(f_1/f_2)^{(2)} = 2.8$. Коэффициент эффективности ввода излучения полупроводникового лазера в ОВС: $K_{\text{max}}^{(1)} = 35$ % — для цилиндрической линзы с фокусным расстоянием $f^{(1)} = 45$ мкм; $K_{\text{max}}^{(2)} = 59$ % — $f^{(2)} =$ = 22.5 мкм.

Схема стыковки полупроводникового лазера с ОВС соответствовала приведенной на рис. 1, е. В эксперименте фокусные расстояния сферических линз выбирались соответственно $f_1 = 20$ мм, $f_2 = 6$ мм, так что $f_1/f_2 = 3,3$. Погрешность установки цилиндрической липзы вдоль оптической оси ~10 % от ее фокусного расстояния. При этом экспериментально достигнутая эффективность ввода излучения одномодового полупро-



Рис. 5. Пучок полупроводникового лазера в дальней зопе без пилиндрической линзы (a), с цилиндрической линзой (б)и на выходе ОВС (в)

водникового лазера в ОВС составила 25 % для цилиндрической линзы с фокусным расстоянием $f^{(1)} = 45$ мкм и 40 % — с $f^{(2)} = 22,5$ мкм. Более низкие экспериментальные значения эффективности ввода по сравнению

с теоретпческими оценками обусловлены главным образом потерями из-за френелевских отражений на линзах, а также гранях ОВС. На рис. 5 приведен пучок полупроводникового лазера в дальней зопе без цилипдрической линзы (a), с цилиндрической линзой j⁽²⁾ = 22,5 мкм (б) и на выходе OBC (\dot{s}).

Таким образом, теоретически и экспериментально показана возможпость стыковки одномодового полупроводникового лазера, имеющего значительную асимметрию днаграммы излучения, с одномодовым волоконным световодом с эффективностью ~40 % путем сочетания методов цилиндрической микролинзы и двух софокусных сферических липз.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Cohen L. G. Power coupling from GaAs injection laser into optical fibers // Bell. Syst. Tech. J. 1972 51. N 3. P. 573.
 Koharzadeh Y. Injection laser coupling to optical wave-guides with integral lenses // J. Appl. Phys. 1976. 47, N 1. P. 477.
 Cohen L. G., Schneider M. V. Microlenses for coupling junction lasers to optical fibers // Appl. Opt. 1974. 13. P. 89.
 Weidel E. Light coupling from a junction laser into monomode-fiber with glass cylindrical lens on the fiber end // Opt. Communs. 1974. 12. P. 93.
 Weidel E. New coupling method for GaAs laser-fiber coupling // Electron. Lett. 1975. 11. P. 436.
 Maeda M., Ikushima L. Nagano K. et al. Hybrid laser to fiber coupler with a culind.

- Maeda M., Ikushima I., Nagano K. et al. Hybrid laser-to-fiber coupler with a cylind-rical lens // Appl. Opt.-- 1977... 16, N 7... P. 1966.
 Saruwatari M., Nawata K. Semiconductor laser to single-mode fiber coupler // Appl. Opt.-- 1979... 18, N 11... P. 1847.
 Lee K. S., Bames F. S. Simple side coupler for coupling between laser diode and single-mode optical fiber // Appl. Opt.-- 1987... 25, N 12... P. 2294.
 Odagiri Y., Shikada M., Kobagashi K. High efficiency laser-to-fiber coupling circuit using a combination of a cylindrical lens and a solffocusing lens. // Electron. Left.--
- using a combination of a cylindrical lens and a selffocusing lens // Electron. Lett.--1977.-- 13, N 14.-- P. 395. Аюнц Ю. Х., Беловолов М. И., Бородулин Б. И. и др. Согласование одномодовых скетоводов с полупроводниковыми дазерами // Квантовая электрон. 1982. 9,
- N₀ 11.
- Saruwatari M., Sugie T. Efficient laser diode to single-mode fiber coupling using a combination of two lenses on confocal condition // IEEE J. of Quant. Electron.-1981.- QE-17. N 6.- P. 1021.
- 12. Kawano K., Saruwatari M., Mitoni O. A new confocal combination lens method for a laser diode module using a single-mode fiber // J. Lightwave Technology .-
- 1985.— LT-3.— P. 739.
 13. Murakami Y., Yamada J., Sakai J. et al. Microlens tipped on a single-mode fiber end for InGaAsP laser coupling improvement // Electron, Lett.— 1980.— 16.— P. 322
- 14. Lee K. S., Bames F. S. Microlenses on the end of single-mode optical fibers for laser
- аpplications // Appl. Opt.— 1985.— 24.— Р. 3134.
 15. Базаров А. Е., Гармаш И., Голдобин И. С. и др. Излучательные характеристики лазерных и суперлюминесцептных диодов с градиентным волокном // ЖТФ.— 1987.-- Ni 5.
- 16. Беловолов М. И., Дианов Е. М., Крюков А. П. Модуль эффективной стыковки промышленного полупроводникового лазера ИЛПН-204 с одномодовым волокопным световодом // Электросвязь.— 1986.— № 8. 17. Yamada J., Murakami Y., Sakai J., Kimura T. Characteristics of a hemispherical
- J. Quantum. Electron. 1980. QE-16. P. 4067. Kayoun P., Puech C., Papuchon M., Arditty H. J. Improved coupling between laser diode and single-mode fiber tipped with a chemically etched self-centered diffracting element # Electron. Lett. 1981. 17. P. 401. 18.
- 19. Когельник Г., Ли Т. Резонаторы и световые пучки лазеров // ТИНЭР. 1966. 54. № 10.
- Kogelnik H. Coupling and conversion coefficients for optical modes // Proc. Symp. on Quasi-Optics.— Brooklyn: Polytechnic Press, 1964.— P. 333.